



汕头华汕电子器件有限公司

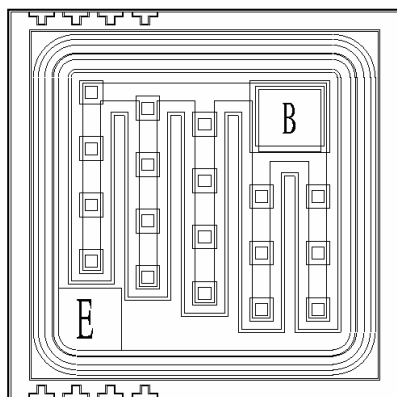
NPN SILICON TRANSISTOR

8050L 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸（100mm）
芯片代码：C065BJ-00
芯片厚度： $240 \pm 20\mu\text{m}$
管芯尺寸： $650 \times 650\mu\text{m}^2$
焊位尺寸：B 极 $105 \times 105\mu\text{m}^2$ ；E 极 $105 \times 105\mu\text{m}^2$
电极金属：铝
背面金属：金
典型封装：S8050，H8050L

管芯示意图



极限值 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

T_{stg} ——贮存温度..... -55~150
 T_j ——结温..... 150
 P_C ——集电极耗散功率..... 1W
 V_{CBO} ——集电极—基极电压..... 40V
 V_{CEO} ——集电极—发射极电压..... 25V
 V_{EBO} ——发射极—基极电压..... 6V
 I_C ——集电极电流..... 1.5A

电参数 ($T_a=25$) (封装形式：TO-92)

参数符号	符 号 说 明	最小值	典型值	最大值	单 位	测 试 条 件
I_{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{\text{CB}}=35\text{V}$ ， $I_{\text{E}}=0$
I_{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	$V_{\text{EB}}=6\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=0$
h_{FE}	直流电流增益	85 40		500		$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=100\text{mA}$ $V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=800\text{mA}$
$V_{\text{BE(ON)}}$	基极—发射极导通电压			1.0	V	$V_{\text{CE}}=1\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=10\text{mA}$
$V_{\text{CE(sat)}}$	集电极—发射极饱和电压		0.2	0.5	V	$I_{\text{C}}=800\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=80\text{mA}$
$V_{\text{BE(sat)}}$	基极—发射极饱和电压			1.2	V	$I_{\text{C}}=800\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=80\text{mA}$
BV_{CBO}	集电极—基极击穿电压	40			V	$I_{\text{C}}=100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{E}}=0$
BV_{CEO}	集电极—发射极击穿电压	25			V	$I_{\text{C}}=2\text{mA}$ ， $I_{\text{B}}=0$
BV_{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	$I_{\text{E}}=100\mu\text{A}$ ， $I_{\text{C}}=0$
f_{T}	特征频率	100			MHz	$V_{\text{CE}}=10\text{V}$ ， $I_{\text{C}}=50\text{mA}$